

トランジスタ

2SC2076

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

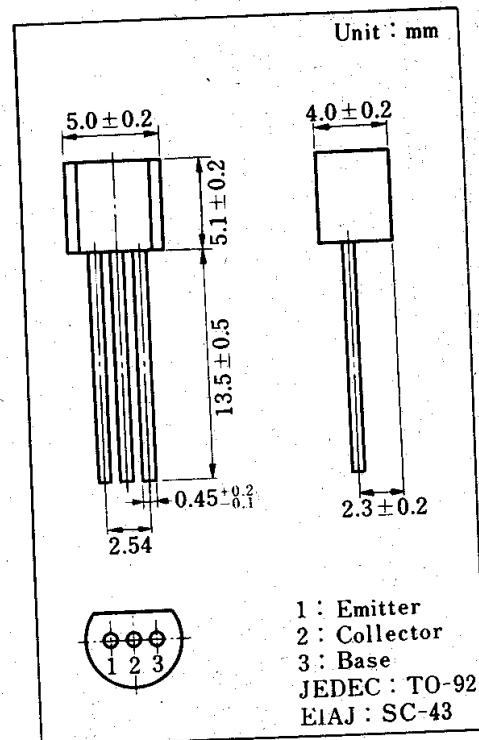
高周波増幅用 / RF Amplifier

■ 特徴 / Features

- AM/FM ラジオの RF 増幅, 発振, 混合, IF に最適です。
Suitable for RF amp., OSC, mix. and IF amp. in FM/AM radios.
- サージ破壊強度が大きい。 / Large with standing capability against surge voltage.

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V _{CBO}	35	V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	30	V
エミッタ・ベース電圧	V _{EBO}	4	V
コレクタ電流	I _C	20	mA
コレクタ損失	P _C	400	mW
接合部温度	T _J	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +150	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	V _{CB} = 20 V, I _E = 0			1	μA
コレクタ・ベース電圧	V _{CBO}	I _C = 10 μA, I _E = 0	35			V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	I _C = 2 mA, I _B = 0	30			V
エミッタ・ベース電圧	V _{EBO}	I _E = 10 μA, I _C = 0	4			V
直流電流増幅率	h _{FE} *	V _{CE} = 10 V, I _C = 1 mA	80		360	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = 10 mA, I _B = 1 mA			0.4	V
トランジション周波数	f _T	V _{CB} = 10 V, I _E = -1 mA	80		200	MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} = 10 V, I _E = 0, f = 1 MHz			3.5	pF
雑音指数	NF	V _{CB} = 10 V, I _E = -1 mA, f = 100 MHz			5	dB

* h_{FE} ランク分類 / h_{FE} Classifications

Class	B	C	D
h _{FE}	80 ~ 160	120 ~ 240	180 ~ 360